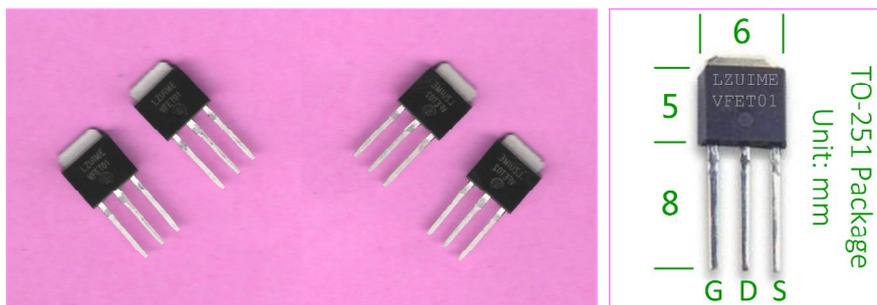


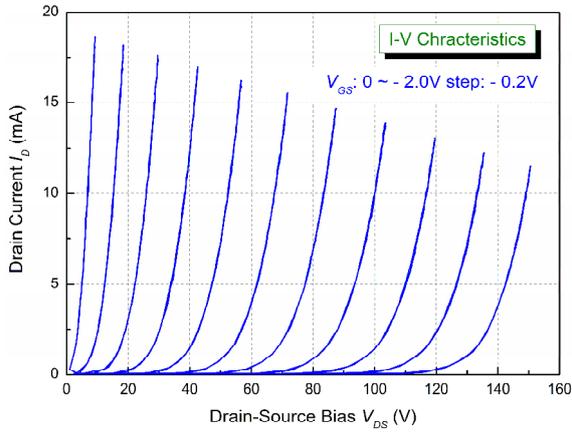
封装形式



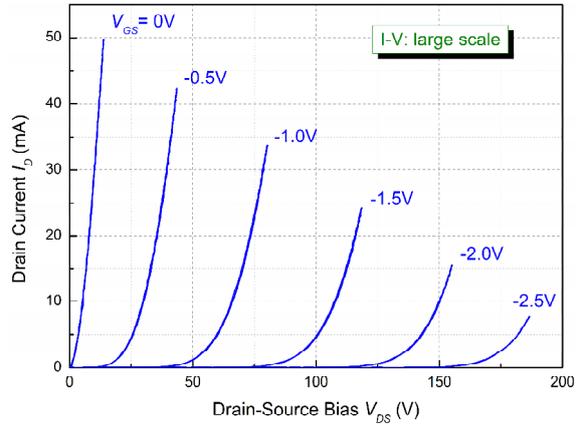
特性参数

项目	符号	测试条件	测量值			单位
			最小值	典型值	最大值	
栅-源击穿电压	BV_{GSO}	$I_S=100\mu A$	—	20		V
栅-漏击穿电压	BV_{GDO}	$I_D=100\mu A$	120	160		V
模式转变电压	V_{TR}	—	0.2	0.3		V
通态压降	V_{ON}	$V_{GS}=0V, I_D=5mA$	9	10		V
栅-源泄漏电流	I_{GSO}	$V_{GS}=-5V$	5	10	—	nA
栅-漏泄漏电流	I_{GDO}	$V_{GD}=50V$	20	30	—	nA
最大漏极电流	$I_{D,max}$	$V_{GS}=0V$	—	100	—	mA
跨导	g_m	$V_{DS}=50V, I_D=5mA$	40	50		mS
电压放大因子	μ	$V_{DS}=50V, I_D=5mA$	50	65		—

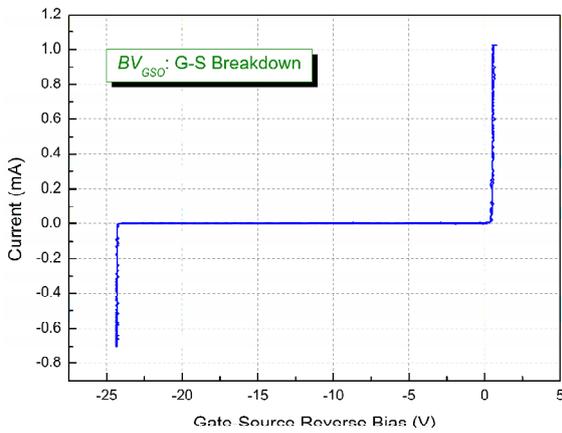
典型特性曲线



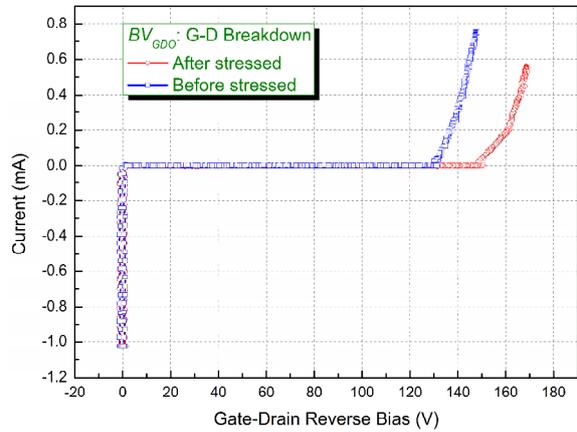
输出特性 (小电流)



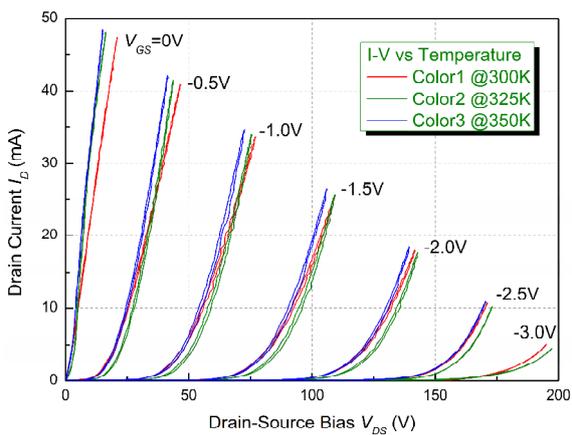
输出特性 (大电流)



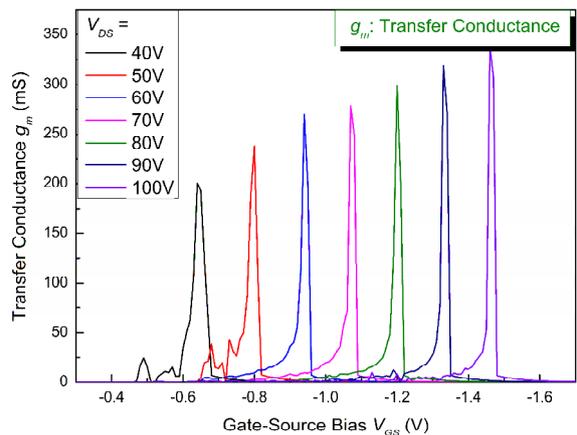
栅-源击穿特性



栅-漏击穿特性



变温特性



转移电导 (跨导)